**Шубина Ксения Юрьевна. Формирование и исследование свойств эпитаксиальных структур GaN/Si(111);[Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»], 2021**